

## SiC素子搭載型高周波電源

# CFRP加工の温間成形用電源

SiC汎用型高周波電源  
HPI-Series



SiC通電加熱用高周波電源  
MEI-Series



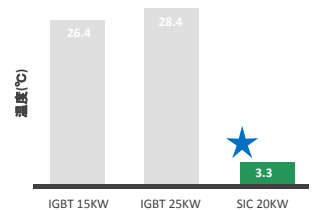
## フルSiC素子採用でさらに省エネになりました

最新の低損失デバイスSiC素子を積極的にとり入れた新しい高周波電源です。

短時間成形を可能とするため、高周波通電加熱を用いて成形金型内での急加熱急冷を実現しました。シミュレーションを基に高い均熱制御性を可能とします。

冷却水が不要になり(インバータ部)、ユーティリティコストを節減(従来比30%減)します。スイッチング素子の発熱量が低減、高温環境下での連続稼働に優れております。

・ デバイス上昇温度 ( $\Delta t$ )



### スイッチング効率2倍

### 空冷でインフラ費用を節減

### 表皮効果による高速加熱

定格出力	10~200kW
周波数	1~250kHz (共振周波数に自動追従)
出力制御範囲	0~100% (連続)

### ・ 従来仕様との比較

	IGBT	MOSFET(Si)	MOSFET(SiC)
周波数	~30kHz	~400kHz	~400kHz
耐電圧	1200V	600V	1200V
損失(抵抗)	大	大	小
特徴	低価格	高い周波数に対応、並列運転が可能	高い周波数に対応、低損失